

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN021	文件编号	XS-W-039
		版本号	15-A5-06
	高频放大环境额定双极型晶体管	页码	1/3

1 主要用途及主要特点

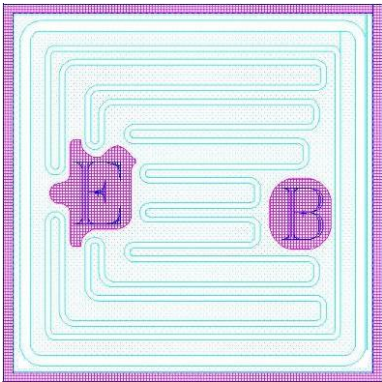
1.1 主要用途

用 W2XN021 芯片封装的成品管主要适用于音频功放电路。

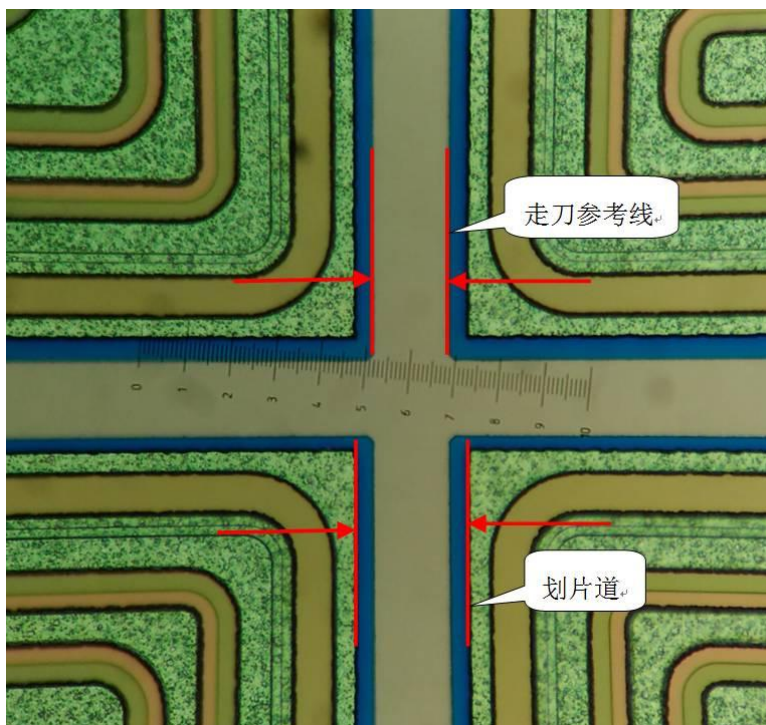
1.2 主要特点

- 饱和压降低
- 击穿电压高

2 芯片数据

芯片示意图 	芯片尺寸 (mm×mm)		0.74×0.74
	芯片厚度 (μm)		220±20
	划片道*尺寸 (μm)		40
	键合区面积 (μm ²)	基区	120×140
		发射区	120×140
	钝化层	Si ₃ N ₄	
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	3.0±0.5
	背面电极金属		金
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求 (推荐)		共晶
	键合要求 (推荐)		铜丝; φ42 μm; E、B 区各一根

* 划片道位置示意图:



备注: 划片道**两侧**的铝条不断裂即判为合格。

江阴新顺微电子有限公司			
地 址:	江苏省江阴市滨江中路 275 号	网 址:	http://www.xinshun.cn
电 话:	(0510) 86851182 86852109	传 真:	(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN021 高频放大环境额定双极型晶体管	文件编号	XS-W-039
		版本号	15-A5-06
		页 码	2/3

3 电特性（在推荐的封装形式、适当的封装条件下）

3.1 极限值

除非另有规定，T_{amb}= 25℃

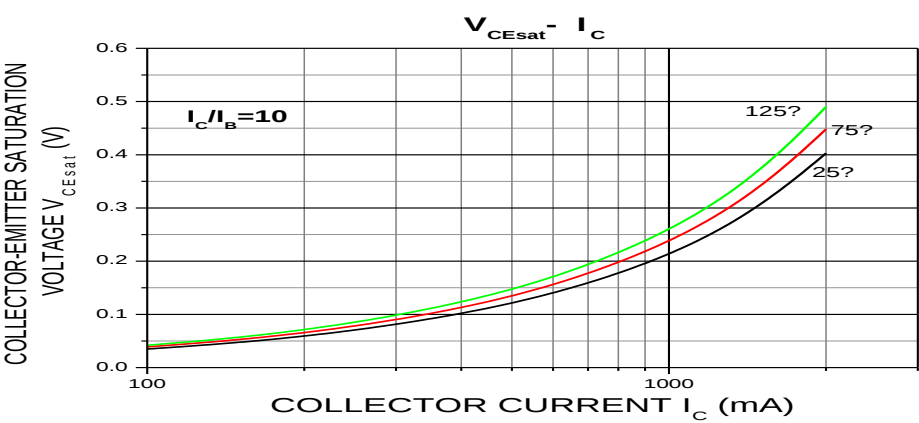
参 数 名 称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基 极电压	V _{CB0}	50	V	推荐封装形式：T0-92L 推荐成品型号：3DG8051
集电极-发射极电压	V _{CE0}	40	V	
发射极-基 极电压	V _{EB0}	5	V	
集电极电流	I _C	2	A	
耗散功率(T _{amb} =25℃)	P _{tot}	0.9	W	
结温	T _j	150	℃	
贮存温度	T _{stg}	-55~150	℃	

3.2 电参数

除非另有规定，T_{amb}= 25℃

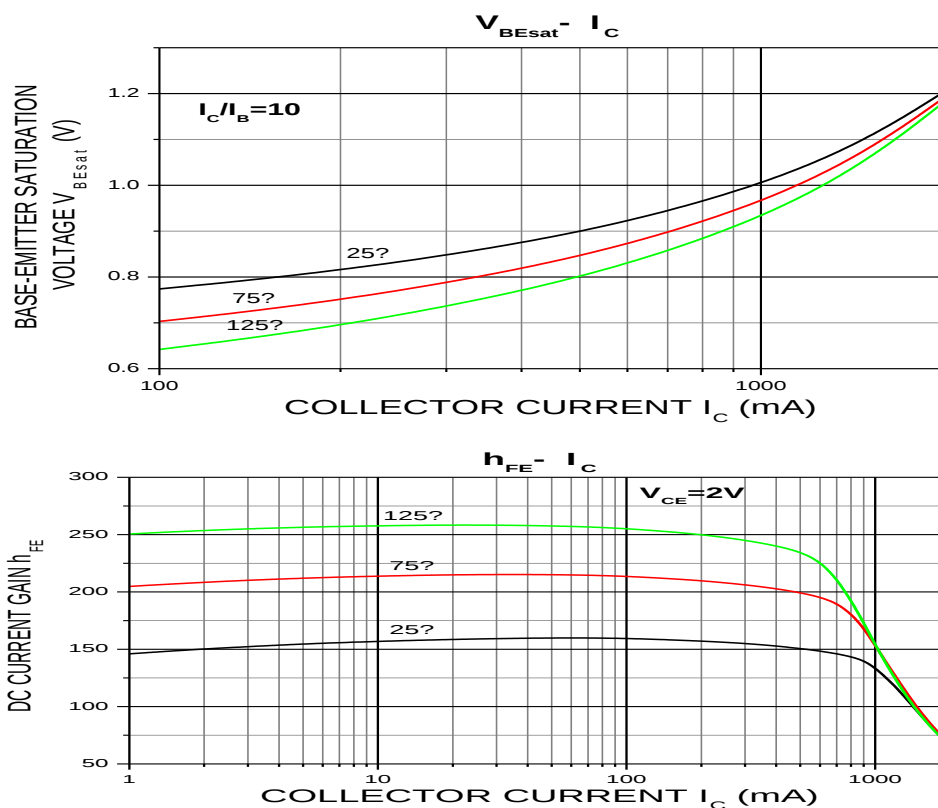
参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} =50V, I _E =0			0.1	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EB0}	V _{EB} =5V , I _C =0			0.1	μ A
共发射极正向电流传输比的静态值	h _{FE}	V _{CE} = 2V, I _C = 500mA	100		320	
集电极-发射极饱和电压	V _{CEsat}	I _C =1A, I _B =100mA			1	V
特征频率	f _T	V _{CE} =10V, I _C =50mA f=100MHz	150			MHz

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司			
地 址：	江苏省江阴市滨江中路 275 号	网 址：	http://www.xinshun.cn
电 话：	(0510) 86851182 86852109	传 真：	(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN021	文件编号	XS-W-039
		版本号	15-A5-06
	高频放大环境额定双极型晶体管	页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司			
地 址：	江苏省江阴市滨江中路 275 号	网 址：	http://www.xinshun.cn
电 话：	(0510) 86851182 86852109	传 真：	(0510) 86851532